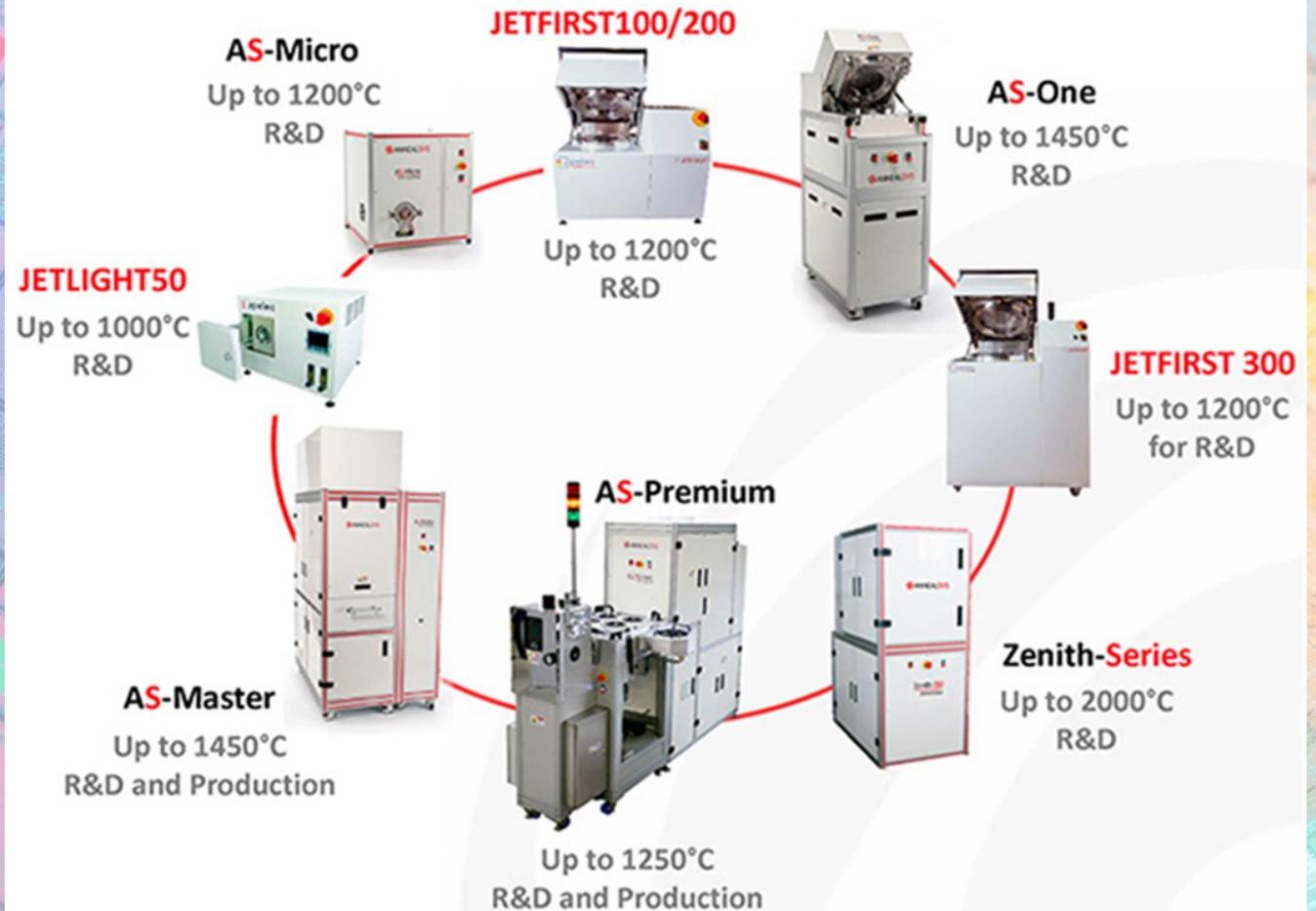


# Rapid Thermal Processing (RTP) Furnaces

เตาให้ความร้อนแก่แผ่นเวเฟอร์  
หรือชั้นสเตรดอย่างรวดเร็วใน  
สภาพแวดล้อมที่ควบคุม



RTP systems from R&D to production



**Typical Processes of Resident Reactions** กระบวนการปฏิกิริยาเหล่านี้  
เป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้

### 1. **Implant annealing** (การอบอ่อนหลังการฝังตัว)

- เป็นกระบวนการให้ความร้อนหลังจากการฝังตัวของสารเจือ (ion implantation)
- ช่วยซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างผลึกที่เกิดจากการฝังตัว
- ทำให้อะตอมของสารเจือเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในโครงสร้างผลึก
- กระตุ้นให้สารเจือทำหน้าที่ทางไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. Ohmic contact annealing (การอบอ่อนหน้าสัมผัสโอล์มิก)

- เป็นกระบวนการให้ความร้อน เพื่อสร้างหน้าสัมผัสที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบโอล์มิก (ความต้านทานคงที่)
- ช่วยให้เกิดการผสมผสานระหว่างโลหะ และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริเวณหน้าสัมผัส
- ลดความต้านทานที่รอยต่อ และปรับปรุงการนำไฟฟ้าระหว่างโลหะและเซมิคอนดักเตอร์
- มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างขั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

### 3. Diffusion of dopants (การแพร่กระจายของสารเจือ)

- เป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอะตอมสารเจือในเนื้อวัสดุเซมิคอนดักเตอร์
- สามารถใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ความเข้มข้นของสารเจือที่เฉพาะเจาะจง
- อัตราการแพร่กระจายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เวลา และชนิดของสารเจือ
- ถูกควบคุมอย่างระมัดระวังเพราะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์

### 4. Densification and crystallization (การทำให้หนาแน่น และการเกิดผลึก)

- เป็นกระบวนการใช้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุ

- การทำให้หนาแน่น ลดช่องว่างและรูพรุนในวัสดุ เพิ่มความหนาแน่น
- การเกิดผลึก เปลี่ยนวัสดุอสัณฐาน (amorphous) ให้เป็นโครงสร้างผลึก (crystalline)
- ใช้บ่อยในการผลิตชั้นฉนวนไดอิเล็กทริก ชั้นวัสดุนำไฟฟ้า หรือชั้นพอลิซิลิคอน

## 5. Thermal annealing of polymers (การอบอ่อนด้วยความร้อนของพอลิเมอร์)

- เป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่วัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ช่วยลดความเค้นภายใน (internal stress) ในชั้นพอลิเมอร์
- ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ และทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์
- สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับโมเลกุลของพอลิเมอร์ เช่น เพิ่มความเป็ผลึก เพิ่มความหนาแน่น หรือเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของโมเลกุล
- ใช้ในวัสดุไดอิเล็กทริกพอลิเมอร์ ฟิล์มบาง หรือสารไวแสงที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโฟโตนิกส์

กระบวนการเหล่านี้มักจะใช้เทคโนโลยี Rapid Thermal Processing (RTP) เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ และเวลาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง

**Resident Reactions Processes** คือกระบวนการที่ใช้ความร้อนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุที่มีอยู่แล้วบนแผ่นเวเฟอร์ โดยไม่มีการเพิ่มวัสดุจากภายนอกเข้าไปเพิ่มเติม

กระบวนการเหล่านี้เป็นหนึ่งในประเภทของการใช้ความร้อนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยหลักการสำคัญคือ การใช้ความร้อนเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยา หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัสดุที่อยู่บนแผ่นเวเฟอร์อยู่แล้ว โดยไม่ต้องนำเข้าวัสดุใหม่

## กระบวนการ **Resident Reactions** ที่สำคัญมีดังนี้

1. **Implant annealing** การอบอ่อนเพื่อกระตุ้นสารเจือที่ถูกลฝังไว้ในเวเฟอร์ และซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างผลึกที่เกิดจากการฝังตัว
2. **Ohmic contact annealing** การอบอ่อนเพื่อสร้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติโอห์มิกระหว่างโลหะ และเซมิคอนดักเตอร์
3. **Diffusion of dopants** การแพร่กระจายของสารเจือในเนื้อเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อสร้างโครงสร้างที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเฉพาะ
4. **Densification and crystallization** การเพิ่มความหนาแน่นของวัสดุ และการเปลี่ยนโครงสร้างจากอสัณฐานเป็นผลึก

**5. Thermal annealing of polymers** การอบอ่อนพอลิเมอร์ด้วยความร้อนเป็นกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ลดความเค้นภายในของชั้นพอลิเมอร์
- ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อน และทางกล
- เพิ่มความแข็งแรงของการยึดเกาะระหว่างชั้นวัสดุ
- ควบคุมอัตราการซึมผ่านของสาร และความชื้น
- ปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้า และทางแสง
- เพิ่มความต้านทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อม

การอบอ่อนพอลิเมอร์มักถูกใช้กับวัสดุ เช่น สารไวแสง (photoresists), วัสดุฉนวนไดอิเล็กทริกพอลิเมอร์ (polymer dielectrics), และชั้นเคลือบป้องกัน (passivation layers) เพื่อให้ได้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และความเสถียรสูง



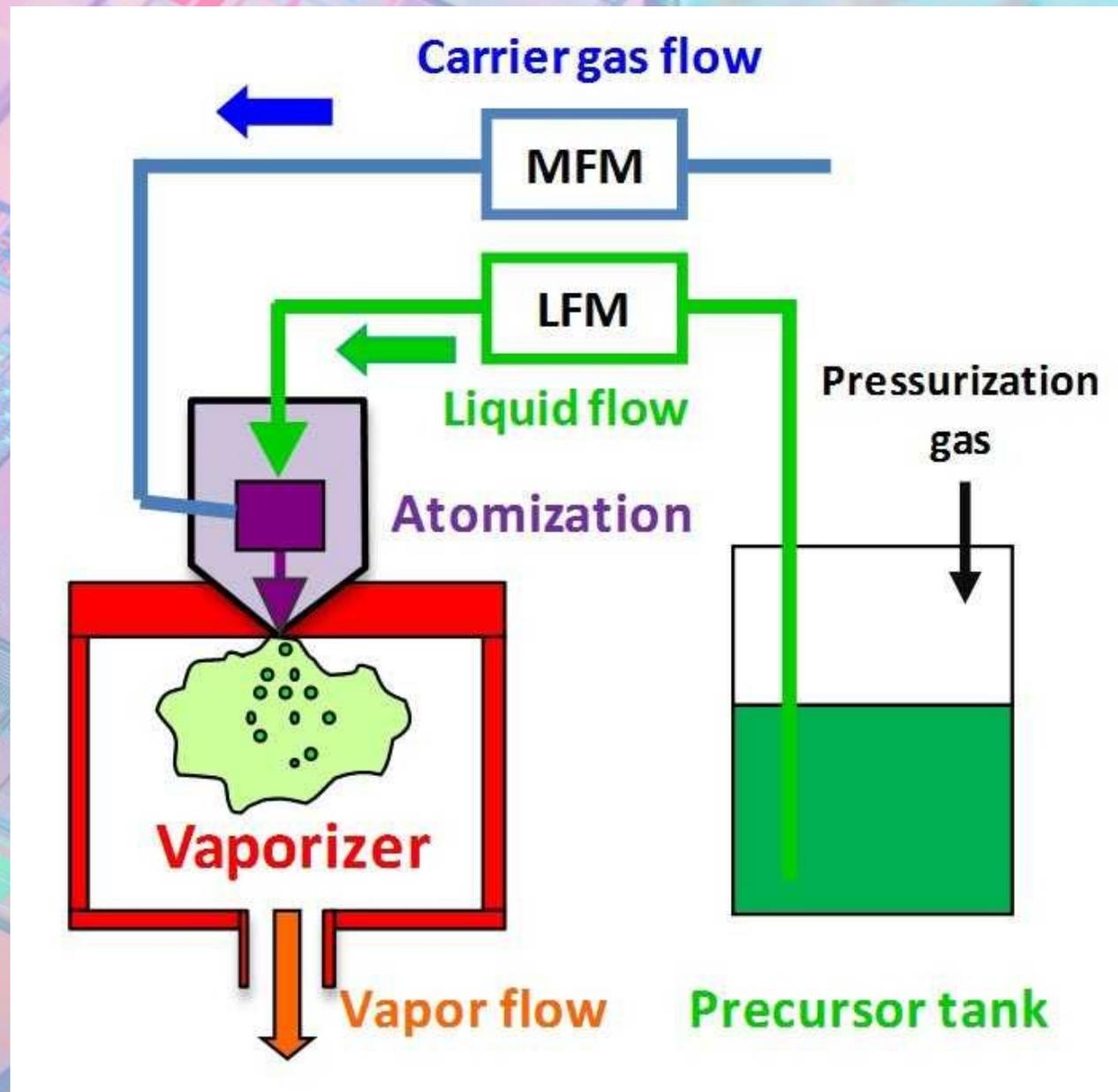
# Direct Liquid Injection (DLI) Deposition Systems

ระบบที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ  
ฟิล์มบางในอุตสาหกรรมเซมิ  
คอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์



## Direct Liquid Injection (DLI) Deposition Systems

คือระบบที่ใช้ในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักการทำงาน และคุณลักษณะสำคัญดังนี้



## หลักการทำงาน

1. ระบบ DLI ทำหน้าที่จัดส่งสารตั้งต้นที่เป็นของเหลว (liquid precursors) เข้าสู่ระบบเคลือบผิว
2. ของเหลวจะถูกฉีดเข้าไปในเครื่องระเหย (vaporizer) ที่มีอุณหภูมิสูง
3. สารตั้งต้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ (vapor) อย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ
4. ไอของสารตั้งต้นจะถูกพาไปยังห้องปฏิกิริยา (reaction chamber) ด้วยก๊าซตัวพา (carrier gas)
5. ในห้องปฏิกิริยา สารตั้งต้นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นผิวของซับสเตรต และสร้างเป็นฟิล์มบาง

## ข้อดีของ DLI

- ควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นได้อย่างแม่นยำ
- ให้ความสม่ำเสมอของฟิล์มที่เคลือบได้ดี
- สามารถใช้กับสารตั้งต้นที่มีจุดเดือดสูงหรือมีความเสถียรทางความร้อนต่ำ
- เหมาะสำหรับการเคลือบฟิล์มที่ต้องการความหนาที่แน่นอนและการควบคุมองค์ประกอบทางเคมีที่แม่นยำ
- ลดการสูญเสียสารตั้งต้นราคาแพง

## การประยุกต์ใช้ของระบบ DLI

1. ใช้ในกระบวนการ Chemical Vapor Deposition (CVD)
2. ใช้ในกระบวนการ Atomic Layer Deposition (ALD)

## การประยุกต์ใช้ของระบบ DLI (ต่อ)

3. การเคลือบวัสดุออกไซด์ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ), ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ )
4. การเคลือบฟิล์มวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric), วัสดุไพโซอิเล็กทริก (piezoelectric)
5. การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)

ระบบ DLI ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ช่วยให้สามารถสร้างโครงสร้างระดับนาโนได้อย่างแม่นยำ และมีคุณภาพสูง